

JP

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-113174

(P2003-113174A)

(43) 公開日 平成15年4月18日 (2003.4.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
C 0 7 D 307/94		C 0 7 D 307/94	2 H 0 2 5
C 0 8 F 20/26		C 0 8 F 20/26	4 C 0 3 7
G 0 3 F 7/033		G 0 3 F 7/033	4 J 1 0 0
7/039	6 0 1	7/039	6 0 1

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願2002-214989 (P2002-214989)

(22) 出願日 平成14年7月24日 (2002.7.24)

(31) 優先権主張番号 特願2001-228844 (P2001-228844)

(32) 優先日 平成13年7月30日 (2001.7.30)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 発明者 大籠 祐二

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社内

(72) 発明者 高橋 裕子

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社内

(74) 代理人 100103997

弁理士 長谷川 暁司

最終頁に続く

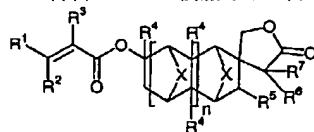
(54) 【発明の名称】 ラクトン構造を有する多環式化合物

(57) 【要約】

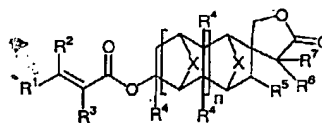
【課題】 エキシマレーザー光を光源とするフォトリソグラフィに用いるレジスト材料のベース樹脂として好

適な重合体を与える単量体を提供する。

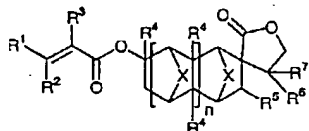
【解決手段】 下記式(1)～(4)で表されるラクトン構造を有する多環式化合物。



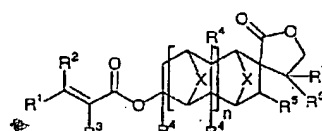
式(1)



式(2)



式(3)



式(4)

(式中、R¹～R⁷は、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す。Xは炭素数1ないし8のアルキル基で置換されているもよいメチレン基もしくはエチレン

基、酸素原子又は硫黄原子を示す。nは0又は正の整数である。)

1

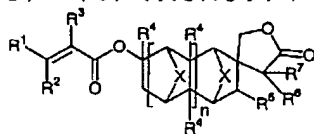
2

【特許請求の範囲】

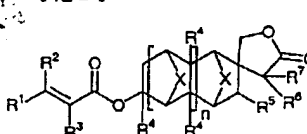
【請求項1】 下記式(1)～(4)で表されるラクト*

*ン構造を有する多環式化合物。

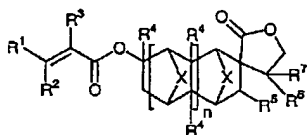
【化1】



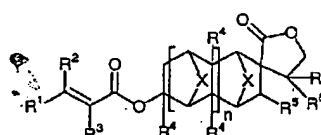
式(1)



式(2)



式(3)



式(4)

(式中、 $R^1 \sim R^7$ は、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す。Xは炭素数1ないし8のアルキル基で置換されていてもよいメチレン基もしくはエチレン基、酸素原子又は硫黄原子を示す。nは0又は正の整数である。)

【請求項2】 nが0、1、2又は3であることを特徴とする請求項1記載のラクトン構造を有する多環式化合物。

【請求項3】 R^1 ないし R^7 のいずれかがアルキル基である場合に、そのアルキル基の炭素数が1～8であることを特徴とする請求項1又は2に記載のラクトン構造を有する多環式化合物。

【請求項4】 Xがメチレン基であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のラクトン構造を有する多環式化合物。

【請求項5】 R^1 及び R^2 が水素原子であり、 R^3 が水素原子又はメチル基であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のラクトン構造を有する多環式化合物。

【請求項6】 R^1 、 R^2 及び R^4 ないし R^7 がいずれも水素原子であり、 R^3 が水素原子又はメチル基であり、Xがメチレン基であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のラクトン構造を有する多環式化合物。

【請求項7】 R^1 、 R^2 及び R^5 ないし R^7 がいずれも水素原子であり、 R^3 が水素原子又はメチル基であり、 R^4 がメチル基又はエチル基であり、Xがメチレン基であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のラクトン構造を有する多環式化合物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明はエチレン性不飽和結合とラクトン構造とを有する新規な多環式化合物に関するものである。本発明に係る化合物を、単独で重合させるか又は他のエチレン性不飽和結合を有する化合物と共※50

※重合させて得られる重合物は、超LSI製造用のレジスト材料のベース樹脂として好適である。

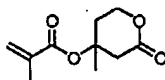
【0002】

【従来の技術】近年、LSIはますます高集積化が進んでおり、パターンルールの更なる微細化が求められている。この要求に適合する次世代の微細加工技術として期待されているのが、遠紫外線リソグラフィーである。なかでもKrFエキシマレーザー光、ArFエキシマレーザー光を光源とするフォトリソグラフィーは、0.3 μ m以下の超微細加工に不可欠な技術として、その実現が切望されている。エキシマレーザー光、特に波長193nmのArFエキシマレーザー光に対して、高い透過性を発揮するレジスト材料のベース樹脂としては、ポリアクリル酸又はポリメタクリル酸の誘導体、及びノルボルネン-無水マレイン酸共重合体などの脂肪族環状化合物を主鎖に含有する高分子化合物が検討されている。ベース樹脂には種々の特性が要求されるが、エッチング耐性及び基板密着性も重要な特性として挙げられている。従来は、性質の異なる複数種の単量体を共重合させることにより、これらの要求を満足させようとしていた。例えば、特開平11-212265号公報には、エッチング耐性を付与する成分としてのアダマンチル、トリシクロデシル、ノルボルニル等の多環式炭化水素基を懸垂基として有する単量体と、基板密着性を付与する成分としての水酸基やカルボキシル基などの極性基を懸垂基として有する単量体とを共重合させることが記載されている。しかし極端に疎水性の大きいエッチング耐性付与単量体と、極端に親水性の大きい基板密着性付与単量体とを均一に共重合させるのは困難であり、単一重合体や意図せぬブロック共重合体などが副生する。このような副生物を含む重合体をレジスト材料のベース樹脂として用いると、膜内層分離による不均一な溶解、高疎水性部位の剥がれによるパターン倒壊、高親水性部位への無秩序な現像液の浸透による膨潤などが起り、レジストの解像性は極めて低いものとなる。

【0003】疎水性単量体と親水性単量体とを共重合させることに伴うこのような問題を回避するものとして、ベース樹脂の原料の単量体として疎水性部位と極性基とを同一分子内に有するものを用いることが検討されている。そしてこのような要求を満たす単量体がいくつも提案されている。例えばR. Dammel et. al., Journal of Photopolymer Science and Technology, Vol. 12, P433 (1999) には、下記式

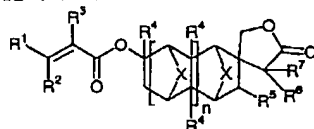
(5) で表される化合物が提案されている。

【0004】
【化2】

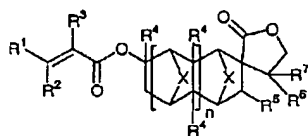


式 (5)

【0005】また、特開平10-274852号公報には下記式(6)で表される化合物が、特開2000-159758号公報には下記式(7)で表される化合物 *



式 (1)



式 (3)

(式中、 $R^1 \sim R^7$ は、それぞれ独立して、水素原子又はアルキル基を示す。Xは炭素数1ないし8のアルキル基で置換されていてもよいメチレン基もしくはエチレン基、酸素原子又は硫黄原子を示す。nは0又は正の整数である。)

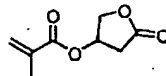
【0009】

【発明の実施の形態】(ラクトン構造を有する多環式化合物)一般式(1)~(4)において、 $R^1 \sim R^7$ のいずれかがアルキル基を表す場合には、その炭素数は通常1ないし20、好ましくは1ないし8、より好ましくは1ないし4、更に好ましくは1ないし2である。アルキル基は直鎖状、分岐鎖状及び環状のいずれであってよい。そのいくつかを例示すると、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、イソブチル基、2-エチルヘキシル基、シクロヘキシル基、及びメチルシクロヘキシル基などが挙げられる。ここで、一般式(1)~(4)で表される化合物の分子量としては、通常、600以下、好ましくは500以下、特に好ましくは400以下、

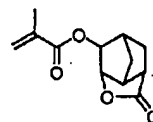
*が、それぞれ提案されている。

【0006】

【化3】



式 (6)



式 (7)

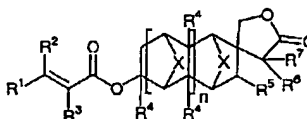
【0007】

10 【発明が解決しようとする課題】これらの化合物はいずれもエッチング耐性と基板密着性に優れた重合体を与えるが、更にエッチング耐性に優れた重合体を与える単量体が求められている。従って本発明はこのような単量体を提供しようとするものである。

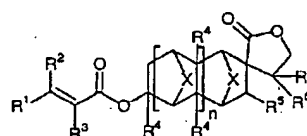
【0008】

【課題を解決するための手段】本発明に係る単量体は、下記式(1)~(4)で表されるラクトン構造を有する多環式化合物である。

【化4】



式 (2)



式 (4)

※0以下である。このうち、 R^1 及び R^2 は共に水素原子であるのが特に好ましい。 R^3 は水素原子又はメチル基であるのが特に好ましい。 R^4 は水素原子、メチル基又はエチル基であるのが特に好ましい。 R^5 ないし R^7 はいずれも水素原子であるのが特に好ましい。nは0又は正の整数であるが、工業的な利用を前提とするならば、0、1、2、又は3であることが好ましく、0又は1であることがより好ましい。また、nが正の整数である場合には、一般式(1)~(4)中の R^4 は複数個存在することになるが、この複数個の R^4 はそれぞれ同一でも異なってもよい。

【0010】一般に或る単量体から得られる樹脂のエッチング耐性は、単量体を構成する炭素、酸素及び水素の原子数間の関係に依存することが知られており、経験的に下記の式(8)及び式(9)で算出される数値がいずれも小さいほど、エッチング耐性が良好であることが知られている。

【0011】

【数1】

$P1 = (\text{分子を構成する炭素原子及び酸素原子の数の和}) / \text{炭素原子の数} \dots (8)$

$P2 = (\text{分子を構成する炭素原子及び水素原子の数の和}) / \text{炭素原子の数} \dots (9)$

【0012】本発明のラクトン構造を有する多環式化合物は、P1の値が1.1～1.4であり、P2の値が2.1～2.4である。例えば、前記の式(5)ないし式(7)で表される化合物と、本発明に係る化合物のうちの代表的なものの一つである、nが0でありR¹、R²及びR³ないしR⁷がいずれも水素原子で、R³がメチル基であり、かつXがメチレン基である化合物とのP1及びP2は次の通りである。

【表1】

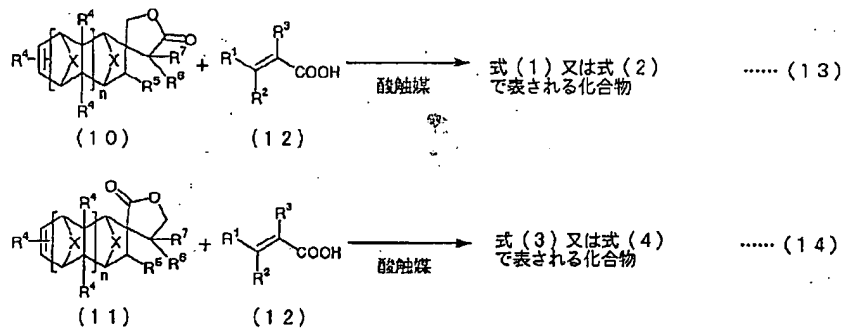
	P1	P2
本発明の化合物	1.25	2.38
式(5)の化合物	1.40	2.40
式(6)の化合物	1.50	2.25
式(7)の化合物	1.33	2.17

*本発明に係る化合物はP1及びP2がいずれも小さく、式(5)～(7)の化合物と同等、ないしはより優れたエッチング耐性を有する樹脂を与えるものである。

(ラクトン構造を有する多環式化合物の製造方法)本発明に係る式(1)～(4)で表される化合物は、下記式(13)又は(14)に従って、一般式(10)又は(11)で表される化合物の二重結合に対するカルボン酸類の付加反応として公知の方法により製造できる。

【0013】

【化5】

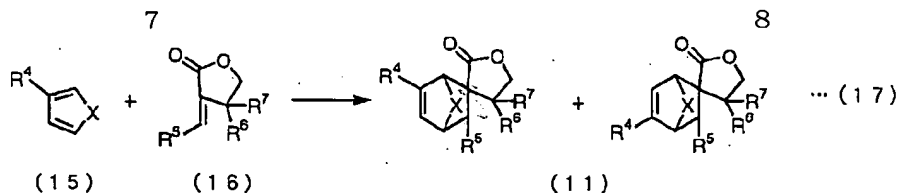


【0014】酸触媒としては、例えば特開平3-10625号公報に開示されている活性白土、特開昭63-8355号公報に開示されている硫酸、A. Heidekum et. al., Journal of Catalysis, Vol. 181, P. 217 (1999)に開示されているイオン交換樹脂、J-M. N. Mebah et. al., New Journal of Chemistry, Vol. 17, P. 835 (1993)に開示されているポリリン酸などを用いればよい。なかでも硫酸を用いるのが好ましい。反応は一般式(10)又は(11)で表される化合物に対して、一般式(12)のカルボン酸を1ないし10倍モル用い、かつ硫酸などの酸触媒を0.05ないし0.5モル倍存在させて行うのが好ましい。反応は無溶媒でも行ない得る ※

※が、所望ならばトルエンなどの炭化水素系溶媒やジオキサンなどのエーテル系溶媒を使用することもできる。反応は室温ないし200℃、特に50ないし150℃で行うのが好ましい。反応終了後は酸触媒を中和して除去したのち、蒸留、晶析、クロマトグラフィーなど常用の手段で目的物を単離、精製することができる。ここで、上記式(11)で表される化合物(n=0)は、下記式(17)に従って、一般式(15)で表される環状ジエン化合物と一般式(16)で表されるメチレンラクトン類とを、Diels-Alder反応により付加させることにより製造できる。

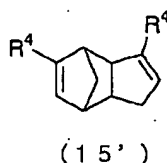
【0015】

【化6】



【0016】この反応は、式(15)で表される化合物と式(16)で表される化合物とを等モル比で混合し、攪拌することによって室温以下でも容易に進行させることができる。また、一般式(15)で表される環状ジエン化合物がシクロペンタジエン類の場合には、下記式(15')で表される化合物の熱分解によって、反応系中で(15)を発生させ、そのまま式(16)で表される化合物と反応させることも可能である。この場合、反応温度は(15')が(15)へ熱分解することのできる温度以上、具体的には150℃以上の温度条件下で実施する必要がある。

【化7】



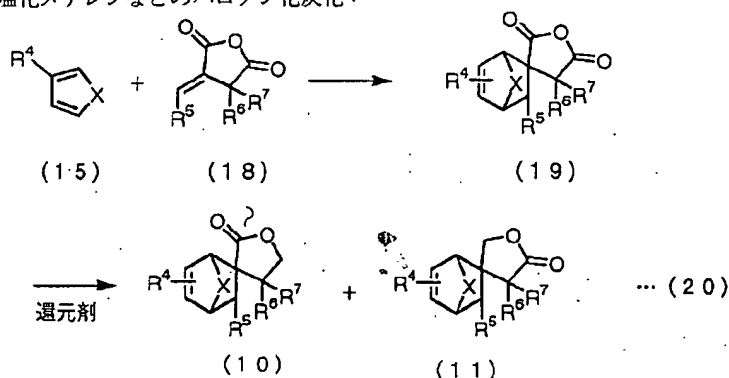
式(15)で表される化合物と式(16)で表される化合物とのDiels-Alder反応において、反応が激しく進行したり、原料または生成物が固体の場合には、トルエンなどの炭化水素系溶媒、エーテルなどの含酸素系溶媒、または塩化メチレンなどのハロゲン化炭化*

* 水素系溶媒などを用いるのが好ましい。反応の進行が緩慢な場合には、加熱したり、触媒量の三フッ化ホウ素などのルイス酸を加えたりすることにより、反応を促進させることができる。得られた反応生成液は、溶媒や未反応原料などを蒸留その他の適宜の手段で除去したのち、そのまま前述のカルボン酸との反応に供することができるが、所望ならば蒸留、晶析、クロマトグラフィーなど常用の手段で精製することもできる。また、式(11)においてnが正の整数である化合物の場合は、上記で得られた生成物と(15)または(15')とをさらに必要回数反応させればよい。この場合の反応温度としては、反応(17)の場合よりも高い温度が必要となる。

一般的には100℃以上300℃以下、好ましくは150℃以上250℃以下である。式(10)又は(11)で表される化合物(n=0)の製造方法としては、別法として、下記式(20)に従って、式(15)で表される化合物と式(18)で表される無水イタコン酸類とをDiels-Alder反応により付加させ、生成した式(19)で表される化合物を還元することによっても製造できる。

【0017】

【化8】



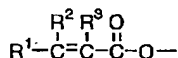
【0018】上記式中のDiels-Alder反応は、上記式(17)で記載したのと同様の条件を取ることができる。また、上記式(15)の代わりに上記式(15')を用いて、反応を行ってもよい。加えて、式(10)又は(11)において、nが正の整数の場合には、上記で得られた中間体(19)と(15)または(15')とをn回繰り返し反応させればよい。その際の反応温度は一般的には100℃以上300℃以下、好ましくは150℃以上250℃以下である。式(20)で示される反応のうちカルボニル基の還元工程に用いられ*

※ 用いる還元剤としては、例えばM. M. Kayser and P. Morand, Canadian Journal of Chemistry, Vol. 56, P. 1524 (1978)などに開示されている金属水素化物を用いることができる。例えば水素化リチウムアルミニウムやその水素原子の一部をアルコールで置換したものや、水素化ホウ素ナトリウムやその水素原子の一部をアルコールで置換したのを用いることができる。反応はエチルエーテルやテトラヒドロフランなどのエーテル系溶媒中で行うのが好ましい。還元剤は化学量

論量ないしは過剰量で使用するのが好ましい。還元反応は一般に -100°C ないし 100°C で行ない得るが、水素化リチウムアルミニウムやその一部アルコラート化物を用いる場合には -78°C ないし -20°C で行うのが好ましく、また水素化ホウ素ナトリウムやその一部アルコラート化物を用いる場合には -20°C ないし 100°C で行うのが好ましい。反応終了後は、酸を加えて還元剤やその酸化生成物を分解したのち、抽出及び水洗により目的物を取得し、前述のカルボン酸との反応に供することができる。勿論、所望ならば蒸留、晶析、クロマトグラフィーなど常用の手段により精製を行うこともできる。なお、上述したところからも明らかなように、本発明に係る一般式(1)～(4)で表される化合物は、通常はこれらの混合物として得られる。またそれぞれの化合物は、環に対する $\text{R}^1\sim\text{R}^7$ 及び

【0019】

【化9】



【0020】基の結合方向により、立体配置を異にする種々の異性体の混合物として得られる。所望ならば晶析やクロマトグラフィーなどによりこれらを相互に分離することもできるが、通常は混合物のままでレジスト材料のベース樹脂の製造に用いる。

【0021】

【実施例】以下に実施例により本発明を更に具体的に説明する。

実施例1

ビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-6-スビロ(2',4'-ジオキソ-3'-オキサ)シクロペンタンの製造;無水イタコン酸80.00g(0.714mol)のテトラヒドロフラン(250ml)溶液に、水冷下、新たにジシクロペンタジエンを熱分解して得たシクロペンタジエン56.37g(0.853mol)を2時間かけて滴下した。滴下終了後、室温で6時間撹拌したのち、室温で一夜放置した。テトラヒドロフランを減圧下で留去後、得られた白色固体を粉碎し、ノルマルヘキサン200ml中に懸濁させ、この懸濁液を1時間室温で撹拌したのち濾過し、濾液をヘキサンで洗浄した。濾液から減圧下でヘキサンを蒸発させたところ、80.825g(0.454mol)のビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-スビロ(2',4'-ジオキソ-3'-オキサ)シクロペンタンが得られた。原料の無水イタコン酸に対する収率は63.5%であった。

【0022】ビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-6-スビロ(2'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタンとビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-6-スビロ(3'-オキソ-4'-オキサ)シクロペンタンの製造;逆流冷却器、温度計及び100ml滴下

ロートを付した容量500mlの3頸フラスコに、撹拌子及びテトラヒドロフラン80mlを仕込み、これに水素化ホウ素ナトリウム4.257g(112.5mmol)を懸濁させた。この懸濁液を氷浴上でフラスコ内温 5°C に冷却した後、滴下ロートよりビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-スビロ(2',4'-ジオキソ-3'-オキサ)シクロペンタン20.46g(114.8mmol)、およびメタノール3.612g(112.7mmol)のテトラヒドロフラン(60ml)溶液を、2時間かけて滴下した。この間、反応温度は 10°C 以下に保った。滴下終了後、 8°C で20分間撹拌し、次いで滴下ロートより2規定塩酸70mlを注意深く加えたところ、無色透明な二層の溶液が得られた。水相(下層)を分取し、減圧下に約50mlまで濃縮して、50mlのトルエンで1回抽出した。一方、テトラヒドロフラン相(上層)は溶媒を減圧下に留去した。残渣にトルエン150mlおよび先に水相を抽出処理して得た50mlのトルエン抽出液を加え、30分間撹拌したのち、不溶の白色固体を濾別して無色透明なトルエン溶液とした。各50mlの飽和炭酸水素ナトリウムで4回洗浄し、次いで各50mlの純水で4回洗浄した。無水硫酸マグネシウム上で乾燥したのち、溶媒を留去し、残留物を減圧蒸留($130^{\circ}\text{C}/5\text{mmHg}$)したところ12.714g(77.43mmol)の無色透明の液体が得られた。このものは 1H-NMR 分析の結果、ビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-スビロ(2'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタンとビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-6-スビロ(3'-オキソ-4'-オキサ)シクロペンタンの混合物であることがわかった、収率は67.4%であった。

【0023】ビスクロ[2.2.1]ヘプタン-6-スビロ(2'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタン-2-イルメタクリレート、ビスクロ[2.2.1]ヘプタン-6-スビロ(2'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタン-3-イルメタクリレート、ビスクロ[2.2.1]ヘプタン-6-スビロ(3'-オキソ-4'-オキサ)シクロペンタン-2-イルメタクリレートおよびビスクロ[2.2.1]ヘプタン-6-スビロ(3'-オキソ-4'-オキサ)シクロペンタン-3-イルメタクリレート混合物の製造;100mlナス型フラスコ中で、上記で得られたビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-スビロ(2'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタンとビスクロ[2.2.1]ヘプタン-2-エン-6-スビロ(3'-オキソ-4'-オキサ)シクロペンタンの混合物12.15g(74.0mmol)、メタクリル酸25.50g(296.2mmol)、及び4-メトキシフェノール14.6mgを混合し均一溶液とした。これに95%濃硫酸1.943g(18.8mmol)を加え、撹拌しながら油浴上で 20°C で2時間保持した。反応液を室温に冷却した後、

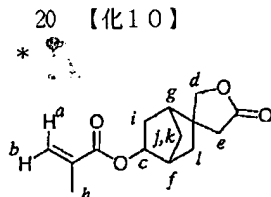
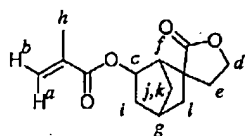
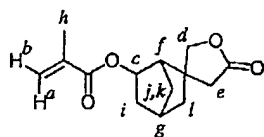
炭酸ナトリウム2.02g(19.06mmol)の水溶液(20ml)を加え、硫酸を中和した。トルエン20mlを加え、撹拌したのち静置して成層分離させた。水相を分離し、油相を70℃/10mmHgで1時間処理し、トルエン及びメタクリル酸を留去した。各20mlの飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で4回洗浄し、さらに各10mlの純水で4回洗浄した。無水硫酸マグネシウム上で乾燥の後、トルエン30mlとクロマト用シリカゲルを加えて懸濁液とした。これを室温で1時間撹拌し、シリカゲルを濾別し、これをトルエンで洗浄して、濾液と洗浄液を合わせた。これから溶媒を留去したところ15.60gの油状黄色透明な生成物を得た。この生成物は室温に放置すると大半が結晶化した。キャピラリ-ガスクロマトグラフィーによって展開すると、少なくとも8種の類似保持時間を示す化合物からなることがわかった。収率は84.2%であった。以下に分析結果を示す。

【0024】(1) 元素分析

実測値: C, 67.31%; H, 7.23%.

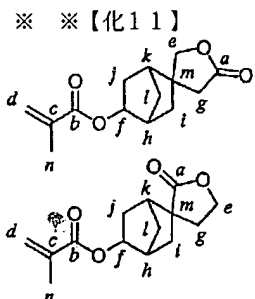
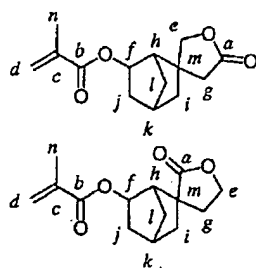
計算値: C, 67.18%; H, 7.25%.

(2) 赤外スペクトル



... (21)

【0026】



... (22)

実施例2

テトラシクロ[6.2.1.1^{3,6}.0^{2,7}]ドデカ-9-エン-4-スピロ(2'-または4'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタンの製造; ビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2-スピロ(2', 4'-ジオキソ-3'-オキサ)シクロペンタン57.5g(350mmol)、ジシクロペンタジエン23.1g(175mmol)とトルエン30mlを誘導撹拌式200mlオートクレーブに仕込み、系内を窒素ガスで置換した★50

* 1770cm⁻¹(ラクトンCO); 1710cm⁻¹(メタクリレートCO).

(3) ¹H-NMR (CDCl₃, δ ppm) 帰属は式(21)参照.

6.09-6.08 (1H, a); 5.56-5.55 (1H, b); 4.87-4.67 (1H, c); 4.30-4.00 (2H, d); 2.61-2.36 (2H, e); 2.20-2.19 (1H, f); 2.14-1.96 (1H, g); 1.93 (3H, h); 1.82-1.66 (2H, i); 1.57-1.47 (2H, j, k); 1.43-1.23 (2H, l).

(4) ¹³C-NMR (CDCl₃, δ ppm) 帰属は式(22)参照.

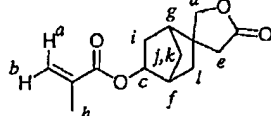
176.6, 176.5 (a); 167.2, 167.1 (b); 136.6, 136.3 (c); 126.0-125.2 (d); 80.3 (e); 76.1, 76.0 (f); 46.2-33.9 (g-m); 18.5, 18.4 (n).

【0025】

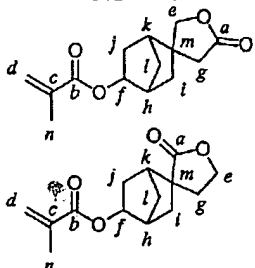
【化10】

20

* Φ



※ ※【化11】



★後、220℃に昇温し、この温度で3時間反応した。冷却後、反応液を取り出して蒸留を行い、165~172℃(0.3mmHg)の留分を19.60g得た。これ及びメタノール19.6g(81.0mmol)のテトラヒドロフラン(50ml)溶液を、水素化ホウ素ナトリウム3.06g(81.0mmol)のテトラヒドロフラン(100ml)懸濁液を氷浴上でフラスコ内温5℃に冷却した中に滴下した。滴下終了後、室温で1時間撹拌し、次いで1規定塩酸80mlを加えた。この溶液

を減圧下で濃縮した後、トルエン100mlで抽出した。各20mlの5重量%炭酸水素ナトリウムで3回洗浄し、次いで各20mlの純水で3回洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥した後溶媒を留去し、蒸留で154~155℃(0.5mmHg)の留分7.42gが得られた。質量分析の結果、 $[M^+]$ が244であり、テトラシクロ[6.2.1. $1^{3,6}$. $0^{2,7}$]ドデカ-9-エン-4-スビロ(2'または4'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタンであることがわかった。

テトラシクロ[6.2.1. $1^{3,6}$. $0^{2,7}$]ドデカ-4-スビロ(2'または4'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタン-9-イル アクリレート
の製造: アクリル酸7.70g(107mmol)、95重量%硫酸0.540g、トルエン7ml及び4-メトキシフェノール3mgを100mlの三ツ口フラスコにいれ、90℃に加熱した。この中にテトラシクロ[6.2.1. $1^{3,6}$. $0^{2,7}$]ドデカ-9-エン-4-スビロ(2'または4'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタン3.10g(13.5mmol)のトルエン3ml溶液を滴下

した後、90℃で3時間加熱した。冷却後、反応液を水10mlに加えた後、トルエン20mlで抽出した。トルエン層を各10mlの5重量%ナトリウム水溶液で3回洗浄し、次いで各5mlの純水で3回洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥した後溶媒を留去したところ、

3.70gの黄色の粘性液体が得られた。質量分析の結果から $[M^+]$ が302であり、テトラシクロ[6.2.1. $1^{3,6}$. $0^{2,7}$]ドデカ-4-スビロ(2'または4'-オキソ-3'-オキサ)シクロペンタン-9-イル アクリレートであることが確認された。

【0027】

【発明の効果】本発明に係る化合物を重合して得られる重合物をベース樹脂とするレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、感度、解像性及びエッチング耐性に優れているため、電子線や遠紫外線による微細加工に有用である。特にArFエキシマレーザー、KrFエキシマレーザーの露光波長での吸収が小さいため、微細で、しかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 内藤 威敏
神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地
三菱化学株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA09 AA14 AB16 AC04 AC06
AC08 AD01 AD03 CB14 CB41
4C037 WA01
4J100 AL08P BA11P BC07P BC08P
BC53P BC83P JA38